ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Микро- и наноэлектроника»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.В.ДВ.02.02 «Проектирование систем в корпусе»

Направление подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»

Направленность (профиль) подготовки Микро- и наноэлектроника

> Уровень подготовки Магистратура

Квалификация выпускника – магистр

Формы обучения – очная, очно-заочная

Оценочные материалы — это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача — обеспечить оценку уровня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

- ПК-1.1 проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
- ПК-4.1 проводит оценочный расчет параметров отдельных аналоговых блоков и СФблока в целом;
- ПК-4.2 разрабатывает уточненный (полный) вариант схемотехнического описания всего аналогового СФ-блока.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на лабораторных работах и практических занятиях. При оценивании результатов освоения лабораторных работ и практических занятий применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Количество лабораторных работ и практических занятий и их тематика определены рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой. Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена. Форма проведения экзамена — устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включается два теоретических вопроса. В процессе подготовки к устному ответу экзаменуемый должен составить в письменном виде план ответа, включающий в себя определения, выводы формул, рисунки, схемы и т.п.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Вид, метод, форма оценочного
/		(или её части)	мероприятия
П			
1	2	3	4
1	Введение. Системы в корпусе	ПК-1.1	экзамен
	аналоговой и цифровой		
	электроники.		
2	Проектирование источников	ПК-1.1	практические
			занятия, экзамен,

	электропитания систем в корпусе.		контроль выполнения
	siekipeimiumsi enerem s kepinjee.		и защита курсовой
			работы
3	Проектирование аналоговых блоков	ПК-1.1	практические
	просктирование аналоговых олоков	1110-1.1	занятия,
	системы в корпусе		лабораторные
			работы, экзамен,
			=
			контроль выполнения
			и защита курсовой работы
4	П 1 С		_ _
4	Проектирование цифровых блоков	ПК-1.1, ПК-4.1, ПК-4.2	практические
	систем в корпусе.		занятия,
	1 3		лабораторные
			работы, экзамен,
			контроль выполнения
			и защита курсовой
	n		работы
5	Запоминающие устройства систем в	ПК-1.1, ПК-4.1, ПК-4.2	практические
	корпусе		занятия, экзамен,
	1 7		контроль выполнения
			и защита курсовой
		TTC 1 1 TTC 1 1 TTC 1 2	работы
6	Проектирование аналого-цифровых	ПК-1.1, ПК-4.1, ПК-4.2	практические
	и цифро-аналоговых		занятия, экзамен,
	11		контроль выполнения
1	преобразователей. Системы сбора		и защита курсовой
	данных.		работы
		ПС 1 1 ПС 4 1 ПС 4 2	
7	Проектирование систем	ПК-1.1, ПК-4.1, ПК-4.2	экзамен
	автоматического контроля.		
	1		

Формы текущего контроля

Текущий контроль по дисциплине «Проектирование систем в корпусе» проводится в виде тестовых опросов по отдельным темам дисциплины, проверки заданий, выполняемых самостоятельно и на лабораторных и практических занятиях, а также экспресс — опросов и заданий по лекционным материалам, лабораторным работам и практическим занятиям. Учебные пособия по дисциплине «Проектирование систем в корпусе», рекомендуемые для самостоятельной работы обучающихся, содержат необходимый теоретический материал, тестовые вопросы по каждому из разделов дисциплины. Результаты ответов на вопросы тестовых заданий контролируются преподавателем.

Формы промежуточного контроля

Формой промежуточного контроля по дисциплине является теоретический экзамен. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом и настоящей программой. Форма проведения экзамена — устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины.

Критерии оценки компетенций обучающихся и шкалы оценивания

Формирование у обучающихся во время обучения в семестре указанных выше компетенций на этапах лабораторных и практических занятий, а также самостоятельной

работы оценивается по критериям шкалы оценок: «зачтено» — «не зачтено». Освоение материала дисциплины и контролируемых компетенций обучающегося служит основанием для допуска обучающегося к этапу промежуточной аттестации — экзамену.

Целью проведения промежуточной аттестации (экзамена) является проверка общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных студентом при изучении дисциплины «Проектирование систем в корпусе».

Уровень теоретической подготовки определяется составом приобретенных компетенций, усвоенных им теоретических знаний и методов, а также умением осознанно, эффективно использовать их при решении задач проектирования систем в корпусе.

Экзамен организуется и осуществляется, как правило, в форме собеседования. Средством, определяющим содержание собеседования студента с экзаменатором, являются экзаменационный билет, содержание которого определяется ОПОП и Рабочей программой. Экзаменационный билет включает в себя, как правило, два вопроса, один из которых относятся к разделам схемотехнического проектирования систем в корпусе, а другой – конструкторско-технологического сопровождения проектирования и производства систем в корпусе.

Оценке на заключительной стадии экзамена подвергаются устные ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора. Применяются следующие критерии оценивания компетенций (результатов):

- уровень усвоения материала, предусмотренного программой;
- умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи;
- полнота, аргументированность, убежденность ответов на вопросы;
- качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция);
- использование дополнительной литературы при подготовке к этапу промежуточной аттестации.

Для количественной оценки экзаменующегося применяется четырехбальная шкала оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что соответствует шкале «компетенции студента полностью соответствуют требованиям $\Phi \Gamma OC$ BO», «компетенции студента соответствуют требованиям $\Phi \Gamma OC$ BO», «компетенции студента в основном соответствуют требованиям $\Phi \Gamma OC$ BO», «компетенции студента не соответствуют требованиям $\Phi \Gamma OC$ BO».

К оценке уровня знаний и практических умений и навыков рекомендуется предъявлять следующие общие требования.

«Отлично»:

глубокие и твердые знания программного материала программы дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы.

«Хорошо»:

достаточно полные и твёрдые знания программного материала дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов.

«Удовлетворительно»:

знание основного программного материала дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов); понимание сущности обсуждаемых вопросов, правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, несущественные ошибки в ответах на дополнительные вопросы.

«Неудовлетворительно»:

отсутствие знаний значительной части программного материала дисциплины; неправильный ответ хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в ответах

на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

Вопросы к практическим занятиям по дисциплине

	вопросы к практическим запятиям по дисциплине
	Практическое занятие № 1 «Источники электропитания систем в корпусе»
1	Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее
	токовое зеркало на биполярных транзисторах.
2	ГСТ на основе "токовых рычагов"
3	Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах.
4	Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе
	стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН.
5	Выпрямители напряжения
6	Стабилизаторы напряжения
7	Импульсные источники электропитания
	Практическое занятие № 2 «Усилительные каскады систем в корпусе»
1	Операционный усилитель
2	Широкополосный усилитель
3	Избирательный усилитель
4	Малошумящий усилитель
5	Инструментальный усилитель
6	Быстродействующий усилитель
7	Прецизионный усилитель
	Практическое занятие № 3 «Преобразователи аналоговых сигналов»
1	Преобразователь ток-напряжение
2	Преобразователь емкость-напряжение
	Практическое занятие № 4 «Преобразователи аналоговых сигналов»
1	Преобразователь напряжение-частота
2	Преобразователь напряжение-временной интервал
	Практическое занятие № 5 «Комбинационно-логические схемы»
1	Шифратор, дешифратор. Обозначения на принципиальных схемах и возможная
	схемотехническая реализация.
2	Мультиплексор, демультиплексор. Обозначение на принципиальных схемах и
2	возможная схемотехническая реализация.
3	Сумматоры, АЛУ. Особенности построения многоразрядных сумматоров и АЛУ
4	Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛМ. Назначение и особенности применения. Практическое занятие № 6 «Комбинационно-логические схемы»
5	триггер. Принцип работы. R-S триггер на логических элементах.
6	Гриттер. Принцип работы. К-3 триттер на логических элементах. Синхронный R-S триггер. Синхронный D-триггер. Двухтактный R-S триггер.
7	Двухтактный D-триггер. Т-триггер. J-К триггер.
8	Регистры. Назначение и разновидности регистров.
9	Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики.
	Трактическое занятие № 7 «Запоминающие устройства систем в корпусе»
1	Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ.
2	Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах.
3	Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ.
4	ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ.
	трактическое занятие № 8 «Проектирование аналого-цифровых и цифро-аналоговых
	образователей. Системы сбора данных»
1	Цифроаналоговое преобразование. Основные принципы преобразования.

2	Структура цифроаналогового преобразователя (ЦАП) с резистивными матрицами R/2 ^N		
	и R-2R.		
3	Основные принципы аналого-цифрового преобразования.		
4	Структурные схемы современных аналого-цифровых (АЦП) преобразователей.		
5	Погрешности ЦАП и АЦП.		
I	Грактическое занятие №9 «Системы сбора данных»		
1	Назначение систем сбора данных.		
2	Структура системы сбора данных		
3	Функциональная схема обобщенной системы сбора данных		
4	Назначение функциональных узлов систем сбора данных.		
6	Применение систем сбора данных.		
I	Грактическое занятие № 10 «Системы управления»		
1	Назначение систем управления технологическим процессом		
2	Структура систем управления технологическим процессом		
3	Функциональная схема обобщенной системы управления технологическим процессом		
4	Назначение функциональных узлов систем управления технологическим процессом		
5	Применение систем управления технологическим процессом		
6	Назначение систем автоматического контроля.		
7	Структура систем автоматического контроля.		
8	Функциональная схема обобщенной системы автоматического контроля.		
9	Назначение функциональных узлов систем автоматического контроля.		
10	Применение систем автоматического контроля.		

Вопросы к лабораторным занятиям по дисциплине

	Пображения побразорным запитиям по дисциплине		
	Лабораторная работа № 1 «Источники электропитания систем в корпусе»		
1	Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее		
	токовое зеркало на биполярных транзисторах.		
2	ГСТ на основе "токовых рычагов"		
3	Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах.		
4	Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе		
	стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН.		
5	Выпрямители напряжения		
6	Стабилизаторы напряжения		
7	Импульсные источники электропитания		
	Лабораторная работа № 2 «Усилительные каскады систем в корпусе»		
1	Операционный усилитель		
2	Широкополосный усилитель		
3	Избирательный усилитель		
4	Малошумящий усилитель		
5	Инструментальный усилитель		
6	Быстродействующий усилитель		
7	Прецизионный усилитель		
	Лабораторная работа № 3 «Комбинационно-логические схемы»		
1	Шифратор, дешифратор. Обозначения на принципиальных схемах и возможная		
	схемотехническая реализация.		
2	Мультиплексор, демультиплексор. Обозначение на принципиальных схемах и		
	возможная схемотехническая реализация.		

3	Сумматоры, АЛУ. Особенности построения многоразрядных сумматоров и АЛУ		
4	Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛМ. Назначение и особенности применения.		
5	Триггер. Принцип работы. R-S триггер на логических элементах.		
6	Синхронный R-S триггер. Синхронный D-триггер. Двухтактный R-S триггер.		
7	Двухтактный D-триггер. Т-триггер. Ј-К триггер.		
8	Регистры. Назначение и разновидности регистров.		
9	Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики.		
	Лабораторная работа № 4 «Системы сбора данных»		
1	Назначение систем сбора данных.		
2	Структура системы сбора данных		
3	Функциональная схема обобщенной системы сбора данных		
4	Назначение функциональных узлов систем сбора данных.		
6	Применение систем сбора данных.		
	Лабораторная работа № 5 «Системы в корпусе для контроля и управления»		
1	Назначение систем управления технологическим процессом		
2	Структура систем управления технологическим процессом		
3	Функциональная схема обобщенной системы управления технологическим процессом		
4	Назначение функциональных узлов систем управления технологическим процессом		
5	Применение систем управления технологическим процессом		
6	Назначение систем автоматического контроля.		
7	Структура систем автоматического контроля.		
8	Функциональная схема обобщенной системы автоматического контроля.		
9	Назначение функциональных узлов систем автоматического контроля.		
10	Применение систем автоматического контроля.		

Вопросы к экзамену

	Тема 1 «Введение»		
1.1	Системы в корпусе цифровой и аналоговой электроники		
	Тема 2 «Схемотехника цифровых блоков систем в корпусе»		
2.1	Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная, восьмеричная,		
	десятичная и шестнадцатеричная системы счисления. Переход из одной системы		
	счисления в другую.		
2.2	Основные логические функции Булевой алгебры. Понятие о логических переменных.		
	Таблицы истинности основных логических функций и их обозначение.		
2.3	Основные тождества и законы Булевой алгебры. Базисные логические функции.		
	Переход из одного базиса в другой.		
2.4	Представление логических функций в аналитическом виде. Понятие минтерма,		
	макстерма.		
2.5	Правила получения логической функции по таблице истинности.		
2.6	Понятие о минимизации логических схем. Графоаналитический метод синтеза и		
	минимизации логических схем. Карты Карно-Вейча.		
2.7	Цифровые интегральные микросхемы. Основные параметры и характеристики.		
2.8	Схемотехника, основные параметры и характеристики ТТЛ элемента со стандартным		
	инвертором.		
2.9	Переходные процессы в ТТЛ элементе.		
2.10	Развитие схемотехники ТТЛ элементов.		
2.11	Разновидности ТТЛ элементов.		
2.12	2 Схемотехника и основные характеристики ЭСЛ элемента.		
2.13	Переходные процессы в ЭСЛ элементе.		
2.14	Многоярусные ЭСЛ элементы.		
2.15	Инжекционные логические элементы. Основные параметры и характеристики.		

 2.17 Схемотехника и основные характеристики КМОП ИМС. 2.18 Шифратор, дешифратор. Обозначения па припципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация. 2.19 Мультиплексор, демультиплексор. Обозначение па припципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация. 2.20 Сумматоры, АЛУ. Особенности постросния многоразрядных сумматоров и АЛУ 2.21 Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛМ. Назначение и особеппости применения. 2.22 Триттер. Принцип работы. R-S триттер на логических элементах. 2.23 Синхронный R-S триттер. Синхронный D-триттер. Двухтактный R-S триттер. 2.24 Двухтактный D-тритгер. Т-триттер. J-К триттер. 2.25 Регистры. Назначение и разновидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики. Тема 3 «Скемотекника элементов памяти систем в корпуссо. 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Облая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти сОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Имкросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусс» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало илсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "гоковых рачагов" 4.3 Токовое зеркало илсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитроное и стабисторое. Упучшение параметро таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база-эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ДРУ. 4.9 Многовходомы куп			
 2.18 Шифратор, дешифратор. Обозначения на принципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация. 2.19 Мультиплекоер, демультиплекоер. Обозначение на принципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация. 2.20 Сумматоры, АЛУ. Особенности построения многоразрядных сумматоров и АЛУ 2.21 Компаратор, мажоритаршый элемент, ПЛМ. Назначение и особенности применения. 2.22 Триттер. Принцип работы. R-S триттер на логических элементах. 2.23 Синхронный R-S триттер. Синхронный D-триттер. Двухтактный R-S триттер. 2.24 Двухтактный D-тритгер. Синхронный D-триттер. Двухтактный R-S триттер. 2.25 Регистры. Назначение и разновидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные припципы работы. Последовательные и парадлельные счетчики. Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусе» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы ДОЗУ. Ситпалы приравления сОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент намяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Ситпалы правысния СОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПОЗУ. 4.7 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметры иОН. 4.5 ИОН с использование напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН а температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные параметры ИРУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Масальный и реальный каскад (ДК). Принции работы и основные характеристики. 4.10 Ссн	2.16	Переходные процессы в ${\rm H}^2{\rm Л}$ элементах. Улучшение параметров таких элементов.	
 2.19 Мультиплекор, демультиплексор. Обозначение на принципиальных схемах в возможная скемотехническая реализация. 2.20 Сумматоры, АЛУ. Особенности построения многоразрядных сумматоров и АЛУ 2.21 Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛМ. Назначение и особенности применения. 2.22 Триттер, Принцип работы. К-S тритгер на логических элементах. 2.23 Синхронный R-S тритер. Синхронный D-тритер. Двухтактный R-S тритер. 2.24 Двухтактный D-тритер. Т-тритер. Ј-К тритер. 2.25 Регистры. Назначение и разновидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и парадлельные счетчики. Тема 3 «Скемотехника элементов памяти систем в корпусе» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти и СОЗУ на бинолярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Ситналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стаблялых токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных траизисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых траизисторах. 4.4 Источники опорного папряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стаблиторнов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ДУ. 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Инсользование напраметры ИРУ. 4.10 Собства ИРУ. Основные параметры ИРУ. 4.11 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.12 ДРУ. Вывод фо	2.17	Схемотехника и основные характеристики КМОП ИМС.	
 2.19 Мультиплексор, демультиплексор. Обозначение на принципиальных схемах и возможная схемотехническая реализация. 2.20 Сумматоры, АЛУ. Особенности потроения многоразрядных сумматоров и АЛУ 2.21 Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛМ. Назначение и особенности применения. 2.22 Тритгер. Принцип работы. R-S тритер на логических элементах. 2.23 Сикронный R-S тритгер. Сикронный В То-гритгер. Двухтактный R-S тритгер. 2.24 Двухтактный D-тритгер. Т-тритгер. J-К тритгер. 2.25 Регистры. Назначение и разновидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики. Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусе» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы ДОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особеппости управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "гоковых рычагов" 4.3 Токово зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного папряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН па основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметры таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база-эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятис ОУ. Основные параметры ИРУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Деальный и реальный ОУ. 4.9 Мпоговходовые устройства па ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальн	2.18	Шифратор, дешифратор. Обозначения на принципиальных схемах и возможная	
 возможная схемотехническая реализация. 2.20 Сумматоры, АЛУ. Особенности построения многоразрядных сумматоров и АЛУ 2.21 Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛМ. Назначение и особенности применения. 2.22 Тригтер. Принцип работы. R-S триггер на логических элементах. 2.23 Синхронный R-S тригтер. Синхронный D-тригтер. Двухтактный R-S тригтер. 2.24 Двухтактный D-тригтер. Т-тригтер. J-К тригтер. 2.25 Регистры. Назначение и разновидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики. Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусс» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных трагаисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разповидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. 7 Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусс» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых траизисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых траизисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилиров и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилиропов и стабисторов. Улучшение параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальной и реальный ОУ. 4.6 Попятие ОУ. Основные параметры ИРУ. 4.7 Типовые охемы включения ОУ. 4.8 Иссочный опорного напряжение база –эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. 4.11 ДРУ. Вывод формулы для выходного		схемотехническая реализация.	
 2.20 Сумматоры, АЛУ. Особепности постросния многоразрядных сумматоров и АЛУ 2.21 Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛМ. Назначение и особенности применения. 2.22 Тритгре. Приници работы. R-S тритгер на логических элементах. 2.23 Синхронный R-S тритгер. Синхронный D-тритгер. Двухтактный R-S тритгер. 2.24 Двухтактный D-тритгер. Т-тритгер. J-К тритгер. 2.25 Регистры. Назначение и разновидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики. Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусс» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Ситналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разповидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ па основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилосна. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база-эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные параметры ИРУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 Индимическая па	2.19	Мультиплексор, демультиплексор. Обозначение на принципиальных схемах	
 2.21 Компаратор, мажоритарный элемент, ПЛМ. Назначение и особенности применения. 2.22 Тритгер. Принцип работы. R-S тритгер с Лихронный R-S тритгер. 2.23 Сикронный R-S тритгер. Сикронный В —тритгер. Духтактный R-S тритгер. 2.24 Двухтактный D-тритгер. Т-тритгер. J-К тритгер. 2.25 Регистры. Назначение и разновидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики. Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусе» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН е использование напряжения база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Ингическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель Погрешности ИРУ. 4.10 Скойства ИРУ. Основные параметры УПТ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного папряжения ДРУ. 4.13 Диференциальный каскад (ДК). Пришип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры		возможная схемотехническая реализация.	
 2.22 Триггер. Принцип работы. R-S триггер на логических элементах. 2.23 Синхропный R-S триггер. Синхропный D—триггер. Двухтактный R-S триггер. 2.24 Двухтактный D-триггер. Т-григгер. J-К триггер. 2.25 Регистры. Назначение и разновидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики. Тема З «Схемотехника элементов памяти систем в корпусе» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало иле бинолярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжение в Вама транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Міоговходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. Погрешности ДРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходные сперамитровты и сосновные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4	2.20		
 2.23 Синхронный R-S триггер. Синхронный D-триггер. Двухтактный R-S триггер. 2.24 Двухтактный D-триггер. Т-триггер. J-К триггер. 2.25 Регистры. Назначение и разновидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и парадлельные счетчики. Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусе» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшеет токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотпошения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные	-		
 2.24 Двухтактный D-триггер. Т-триггер. J-К тригтер. 2.25 Регистры. Назначение и разновидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и парадлельные счетчики. Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусе» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычатов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного папряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабильтиронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база-эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. Погрешности ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. ОУ. Основные параметры ИС. Тособы балансировки ДК. 4.13 Различные скемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. Способы балансировки ДК.<td></td><td>Триггер. Принцип работы. R-S триггер на логических элементах.</td>		Триггер. Принцип работы. R-S триггер на логических элементах.	
 2.25 Регистры. Назначение и разповидности регистров. 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и парадлельные счетчики. Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусе» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разповидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. 3.6 Теме 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычатов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрепности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрепности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифереепциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскады ДК		Синхронный R-S триггер. Синхронный D-триггер. Двухтактный R-S триггер.	
 2.26 Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики. Тема 3 «Скемотехника элементов памяти систем в корпусе» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Ситналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идсальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Лиференциальный каскад, (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. <li< th=""><td>2.24</td><td>Двухтактный D-триггер. Т-триггер. J-K триггер.</td></li<>	2.24	Двухтактный D-триггер. Т-триггер. J-K триггер.	
 Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусе» 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Ситналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. 7 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идсальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Лиференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузак (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскадый ДК. ДК с о схемами Дарлинтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады СКВИТ ССВЕТСКОВ В ВКОВИТОВ В ВКОВИТОВ ВЫ	2.25		
 3.1 Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ. 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разповидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусс» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база-эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идсальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель. ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлинттона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады О	2.26	Счетчики. Основные принципы работы. Последовательные и параллельные счетчики.	
 3.2 Элемент памяти СОЗУ на биполярных транзисторах. 3.3 Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база-эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлинттона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвита уровня и выходные каскады ОУ. 		Тема 3 «Схемотехника элементов памяти систем в корпусе»	
 3.3 Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ. 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ. 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлинтгона. 4.19 ДК с траизисторами супер бетта. ДК на полевых траизисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	3.1	Запоминающие устройства. Классификация ЗУ. Общая структура ЗУ.	
 3.4 ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ. 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемями Дарлингтона. 4.19 ДК с траизисторами супер бетта. ДК на полевых траизисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 		1 1 1	
 3.5 Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	3.3	Микросхемы СОЗУ. Сигналы управления СОЗУ.	
 блоков памяти на ИМС ДОЗУ. 3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база → эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	3.4	ДОЗУ. Элемент памяти и структура ДОЗУ.	
3.6 ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ. Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель. ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Диференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики.	3.5	Микросхемы ДОЗУ. Особенности управления микросхемами ДОЗУ. Построение	
 Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе» 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодель. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 		блоков памяти на ИМС ДОЗУ.	
 4.1 Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	3.6	ПЗУ. Разновидности и классификация ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. Микросхемы ПЗУ.	
токовое зеркало на биполярных транзисторах. 4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ.		Тема 4 «Схемотехника аналоговых блоков систем в корпусе»	
4.2 ГСТ на основе "токовых рычагов" 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20	4.1	Генераторы стабильных токов в ИМС. Назначение и основные параметры. Простейшее	
 4.3 Токовое зеркало Уилсона. ГСТ на полевых транзисторах. 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 			
 4.4 Источники опорного напряжения в ИМС. Основные параметры. ИОН на основе стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	-		
стабилитронов и стабисторов. Улучшение параметров таких ИОН. 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ.			
 4.5 ИОН с использование напряжение база—эмиттер. ИОН с температурной компенсацией. 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	4.4		
 4.6 Понятие ОУ. Основные характеристики ОУ. 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 			
 4.7 Типовые схемы включения ОУ 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметрь ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 			
 4.8 Идеальный и реальный ОУ. 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 		1 1	
 4.9 Многовходовые устройства на ИРУ 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 			
 4.10 Свойства ИРУ. Основные параметры ИРУ. Влияние различных факторов на параметры ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 		•	
 ИРУ. 4.11 Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	-		
реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ.	4.10		
реальности макромодели. Погрешности ИРУ. 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ.	4.11	Статическая макромодель ОУ. Основные параметры и соотношения для ИРУ с учетом	
 4.12 ДРУ. Вывод формулы для выходного напряжения ДРУ. 4.13 Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ. 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 			
 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	4.12		
 4.14 УПТ. Особенности схем. Параметры УПТ. 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	4.13	Различные схемы включения ДРУ. Погрешности ДРУ.	
 4.15 Дифференциальный каскад (ДК). Принцип работы и основные характеристики. 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	4.14		
 4.16 Основные параметры ДК. Способы балансировки ДК. 4.17 Динамическая нагрузка (ДН) в ДК. ДК с несимметричной ДН. 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	4.15		
 4.18 Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона. 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 			
 4.19 ДК с транзисторами супер бетта. ДК на полевых транзисторах. 4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу. 4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ. 	4.17		
4.20 Схемы ДК с переходом к несимметричному выходу.4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ.	4.18	Каскодный ДК. ДК со схемами Дарлингтона.	
4.21 Каскады сдвига уровня и выходные каскады ОУ.	4.19		
	4.20		
4.22 Частотные и скоростные свойства ОУ. Коррекция ОУ. Частотная зависимость полной	4.21		
11 '	4.22	Частотные и скоростные свойства ОУ. Коррекция ОУ. Частотная зависимость полной	
амплитуды ОУ.		амплитуды ОУ.	
4.23 ОУ µА702 и 140УД1. Особенности схемотехники.	4.23	ОУ μΑ702 и 140УД1. Особенности схемотехники.	
4.24 ОУ µА709. Особенности схемотехники.	4.24	ОУ μΑ709. Особенности схемотехники.	

4.25	ОУ μΑ741 с каскодным ДК. Особенности схемотехники.	
4.26	Схемотехника ОУ с каскадом на транзисторах супер бетта.	
4.27	Схемотехника ОУ с программируемыми свойствами.	
4.28	Компараторы. Основные требования и характеристики. Особенности схемотехники	
	компаратора µА710.	
4.29	Компараторы. Основные требования и характеристики. Особенности схемотехники	
	компаратора LM111.	
	Тема 5 «Схемотехника аналого-цифровых и цифро-аналоговых схем»	
5.1	Цифроаналоговое преобразование. Основные принципы преобразования.	
5.2	Структура цифроаналогового преобразователя (ЦАП) с резистивными матрицами R/2 ^N	
	и R-2R.	
5.3	Основные принципы аналого-цифрового преобразования.	
5.4	Структурные схемы современных аналого-цифровых (АЦП) преобразователей.	
5.5	5 Погрешности ЦАП и АЦП.	
Тема 9 «Заключение»		
6.1	Тенденции развития систем в корпусе	

Перечень типовых тем курсовых работ

1	Проектирование системы в корпусе для дишифрации
2	Проектирование системы в корпусе для блока шифрации
3	Проектирование системы в корпусе для мультиплексирования сигналов
4	Проектирование системы в корпусе для демультиплексирования сигналов
5	Проектирование системы в корпусе для контроля техпроцесса
6	Проектирование системы в корпусе для сбора данных РСГУ
7	Проектирование системы в корпусе для сбора данных ВАХ
8	Проектирование системы в корпусе для сбора данных ВФХ
9	Проектирование системы в корпусе для сбора данных НЧ шумов
10	Проектирование системы в корпусе для сбора данных ТСД
11	Проектирование системы в корпусе для сбора данных ТСЕ
12	Проектирование системы в корпусе для оптических исследований

Аттестация студента по представленной курсовой работе (КР) осуществляется на основании следующих критериев:

Шкала оценивания	Критерий	
Зачтено	-Студент строго соблюдал график выполнения КР;	
с оценкой	–содержание КР полностью соответствует заданию;	
«онрицто»	-содержание KP полностью соответствует предъявляемым методическим требованиям;	
	 – разделы задания выполнялись полностью самостоятельно, студент проявил творческий подход к решению задач КР. 	
	Процедура защиты КР	
	 доклад и презентация полностью отражают результаты, 	
	полученные студентом и представленные в КР;	
	– студент показал базовые знания вопросов содержания КР,	
	свободно оперировал данными, полученными в КР;	
	 результаты, полученные студентом, обладают научной новизной 	

Шкала оценивания	Критерий
	и(или) практической значимостью; студент правильно и грамотно ответил на все поставленные вопросы.
Зачтено с оценкой «хорошо»	-Студент в основном соблюдал график выполнения КР; -содержание КР полностью соответствует заданию; -содержание КР в основном соответствует предъявляемым методическим требованиям; студентом допущены несущественные ошибки, КР выполнена с незначительными замечаниями по оформлению; -разделы задания выполнялись в основном самостоятельно с определенной консультационной поддержкой со стороны руководителя, студент проявил творческий подход к решению задач КР.
	Процедура защиты КР — доклад и презентация полностью отражают результаты, полученные студентом и представленные в КР; — студент показал знания вопросов темы КР, оперировал данными, полученными в КР; — при ответах на вопросы были допущены ошибки, которые носят несущественный характер;
Зачтено	-Студент не пунктуально соблюдал график выполнения КР без
с оценкой	уважительной причины;
«удовлетворите	 содержание КР соответствует заданию;
льно»	 –КР имеет поверхностный анализ темы и задания, большинство материалов скомпилировано из существующих источников без необходимого осмысления, имеет нечеткую последовательность изложения материала, студентом допущены существенные ошибки, КР выполнена с многочисленными замечаниями по оформлению; – разделы задания выполнялись самостоятельно лишь частично, консультационная поддержка со стороны руководителя не была должным образом воспринята студентом.
	Процедура защиты КР: - доклад и презентация поверхностны, не полностью отражают основные - результаты, полученные студентом и представленные в КР; - результаты, полученные студентом, не обладают научной новизной и(или) практической значимостью, предложения и рекомендации не имеют достаточного обоснования; - студент не дал полных и аргументированных ответов на заданные вопросы.
Не зачтено	-Студент не соблюдал график выполнения KP без уважительной
с оценкой «неудовлетворит ельно»	причины; – KP не полностью соответствует заданию; не имеет детализированного анализа собранного материала, представленные материалы скомпилированы из существующих
	источников без необходимого осмысления, —студентом допущены принципиальные ошибки в изложении

Шкала оценивания	Критерий
	материала, КР не соответствует требованиям к оформлению;
	 –разделы задания КР выполнялись не самостоятельно,
	консультационная поддержка со стороны руководителя не
	оказывалась по причине неявки студента.
	Процедура защиты КР: –доклад и презентация выполнены без должной связи с результатами КР;
	-студент затруднился ответить на поставленные вопросы или допустил в ответах принципиальные ошибки.

Составил

к.ф.-м..н., доцент кафедры микро- и наноэлектроники

Гудзев В.В.

Зав. кафедрой микро- и наноэлектроники д.ф.-м.н., доцент

Литвинов В.Г.